**第十六届全国MOCVD学术会议[[1]](#footnote-2) （题目使用黑体三号）**

作者, 作者\* , 作者（作者栏使用宋体四号）

南昌大学，国家硅基LED工程技术研究中心，南昌 330000

\*通讯作者：电话/传真： 邮箱：xxx@ncu.edu..cn

(地址和单位栏使用宋体5号)

说明：正文使用宋体5号字，重要数据需要添加图表，图表说明使用宋体5号字，英文使用Times New Roman，参考文献正文采用同样字体。整个摘要不超过1页A4版面，页边距（上下左右）均为2.54厘米。

金属有机化学气相淀积（MOCVD）技术自二十世纪六十年代提出以来，取得了飞速进步，已经广泛应用于制备III族氮化物、III-V族化合物、碲化物、氧化物等重要半导体材料及其量子结构，极大地推动了光电子器件和微电子器件与芯片的发展及产业化，也成为半导体超晶格、量子阱、量子线、量子点结构材料与器件研究的关键技术。未来MOCVD技术的发展将会给化合物半导体科学技术和产业发展带来更为广阔的前景。
  作为MOCVD技术和化合物半导体材料器件研发交流的平台，自1989年第一届会议举办以来，“全国MOCVD学术会议”已经成功举办了十五届，会议规模和影响力越来越大，成为全国学术界和产业界广泛参与的学术盛会。本次会议以“先进光电技术·智能绿色制造”为主题，将于2020年8月4-7日在安徽屯溪举行，与来自祖国大陆和港澳台地区的与会专家学者、工程技术人员和企业家将在MOCVD生长机理与外延技术、MOCVD设备（整机/部件/配件/原材料）、材料结构与物性、光电子器件、电力电子器件、微波射频器件、LED智能照明与物联网、半导体激光器、光伏/光探测器、可见光通信技术等领域开展广泛交流，了解发展动态，促进相互合作。这次会议必将对我国MOCVD学术研究、技术进步及第三代半导体产业发展起到有力的推动作用。

1. 国家自然科学基金（XXXXXXX）和863计划（XXXXX）资助项目 [↑](#footnote-ref-2)